**Схема эксперимента.**

Излучение происходит из поворотного дипольного магнита с полем 0.434±? Тл пучком электронов энергией 4.5±? ГэВ. Натуральный эмиттанс 141±? пм/рад. Продольный размер 30±? мм. Энергетический разброс 3.22\*10-4. (Короч надо будет таблицей сделать. Вообще, такой здоровый эмиттанс весьма размазывает интенсивность, там несколько процентов разница имеется)

Расстояние от точки излучения до испытуемого образца 20±? м (Точность не оценивалась, может встать колом при расчёте дозы)

СИ ограничено прямоугольной щелью, образуемую пластинами, выполненными из сплава эльконайта, толщиной 5 мм. Пластины прикреплены к моторизированным приводам, которыми задаётся размер щели, перемещая пластины с точностью 10 мкм.

Монохроматором выступает кремниевый разрезной кристалл-бабочка (ну или как там его) ориентации (111). Юстировка монохроматора проводилась по краю поглощения медной фольги с систематической ошибкой ? эВ (край поглощения не разрыв 1 рода, а имеет ограниченную ширину, не помню, на каком участке края был выбран репер).

Первый эксперимент. Под действием монохроматического СИ энергий ?,?,? эВ измерялась вольт-амперная характеристика. Пин-диод облучался через образованную щель по всей своей чувствительной области или областью ?х? мм по вертикали и горизонтали, соответственно, относительно центра чувствительной области (Надо уточнить).

Второй эксперимент. Случайный чувствительный участок диода размером ?х? мм облучался в течение 30 минут прямым СИ. До и после облучения на диоде измерялось напряжение, во время его перемещения по вертикали относительно пучка СИ, образованного щелью ? мм по вертикали. Напряжение диода сопоставлялось его положению по вертикали, результат показан на рис.??.